



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

**H928S**

对应国外型号  
KSA928A

**主要用途**

作音频放大。

**外形图及引脚排列**

**极限值** ( $T_a=25$  )

$T_{stg}$ ——贮存温度..... -55~150

$T_j$ ——结温..... 150

$P_C$ ——集电极耗散功率..... 750mW

$V_{CBO}$ ——集电极—基极电压..... -30V

$V_{CEO}$ ——集电极—发射极电压..... -30V

$V_{EBO}$ ——发射极—基极电压..... -5V

$I_C$ ——集电极电流..... -2A



**电参数** ( $T_a=25$  )

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$BV_{CBO}$	集电极—基极击穿电压	-30			V	$I_C=-100\mu A, I_E=0$
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	-30			V	$I_C=-10mA, I_B=0$
$BV_{EBO}$	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-1mA, I_C=0$
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			-100	nA	$V_{CB}=-30V, I_E=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			-100	nA	$V_{EB}=-5V, I_C=0$
HFE	直流电流增益	100		320		$V_{CE}=-2V, I_C=-500mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-2	V	$I_C=-1.5A, I_B=-30mA$
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压			-1	V	$V_{CE}=-2V, I_C=-500mA$
$f_T$	特征频率		120		MHz	$V_{CE}=-2V, I_C=-500mA$
$C_{ob}$	共基极输出电容		48		pF	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$

**分档及其标志**

0	Y
100—200	160—320